

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

CLIPPEDIMAGE= JP408222682A

PAT-NO: JP408222682A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08222682 A

TITLE: LEAD FRAME AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

PUBN-DATE: August 30, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

YAMADA, JUNICHI
KAMI, TOMOE
SASAKI, MASARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME
DAINIPPON PRINTING CO LTD

COUNTRY
N/A

APPL-NO: JP07047919

APPL-DATE: February 14, 1995

INT-CL (IPC): H01L023/50;H01L021/60

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a lead frame adaptable to multi-terminal design of semiconductor devices and after-process such as assembling and mounting steps by making one face of the top end of each inner lead parallel to the faces of other parts thereof and the other three faces thereof recessed.

CONSTITUTION: A lead frame 10 for resin-sealed semiconductor devices mounts a semiconductor element on inner lead tip parts 11A through bumps and electrically connects it to external circuits by outer leads 12 integrated with inner leads 11. The tip part 11A is thinner than other parts of the frame 10 and nearly rectangular in cross-section. One face of the

part 11A is parallel
to other parts faces of the frame 10 and other three faces
of the lead 11 are
made recessed.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(SI)IntCl.*	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H O I L 23/50			H O I L 23/50	U
				A
21/60	3 1 1		21/60	3 1 1 R

(21) 出願番号 特願平7-47919

(22) 出願日 平成7年(1995)2月14日

(71) 出願人 000002897
大日本印刷株式会社
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72) 発明者 山田 淳一
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
大日本印刷株式会社内

(72) 発明者 上 智江
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
大日本印刷株式会社内

(72) 発明者 佐々木 賢
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
大日本印刷株式会社内

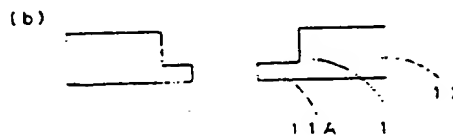
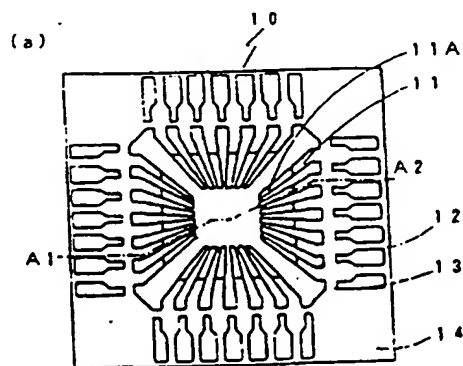
(74) 代理人 弁護士 小西 淳美

(54) 【発明の名称】 リードフレームおよびその製造方法

(五)【要約】

【目的】 半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、プロセス工程や実装工程等の後工程にも対応できる高精度なリードフレームを提供する。

(構成) 半導体素子をバンプを介してインナーリード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウトワタリードにより半導体素子と外部回路とを電気的に接続する。樹脂封止型半導体装置用リードフレームであって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の2面は凹状に形成されている。



【0004】これに対応する方法として、アウターリードの体感を確保したまま微細化を行う方法で、インナーリード部分をハーフエッチングもしくはプレスにより薄くしてエッチング加工を行う方法が提案されている。しかし、プレスにより薄くしてエッチング加工をおこなう場合には、後工程においての精度が不足する（例えば、めっきエリアの平滑性）、ボンディング、モールドイング時のクランプに必要なインナーリードの弾力性、寸法精度が確保されない、製版を2度行なわなければならない等製造工程が複雑になる、等問題点がある。そして、インナーリード部分をハーフエッチングにより薄くしてエッチング加工を行う方法の場合にも、製版を2度行なわなければならない。製造工程が複雑になるという問題が、コスト、実用性、信頼性、生産性、品質の面で発生し、飛躍的な進歩を阻害する。

【課題を解決するための手段】本発明のリードフレームは、半導体素子をバンパを介してインナーリード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを電気的に接続する、樹脂封止型半導体装置用リードフレームであって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、且つ、該インナーリード先端部の一面はリードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の三面は凹状に形成されていることを特徴とするものである。また、本発明のリードフレームの製造方法は、半導体素子をバンパを介してインナーリード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを電気的に接続する、樹脂封止型半導体装置用リードフレームであって、半導体素子をバンパを介して搭載するインナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、前記インナーリード先端部の一面は、リードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の三面は凹状に形成されていることを特徴とする。

Page 1 of 1

中、10はリードフレーム、11はインナーリード、11Aはインナーリード先端部、12はアウターリード、13はダムバー、14はフレーム部を示している。本実施例のリードフレームは、図1(a)に示すように、半導体素子をバンプを介して搭載するための3つのインナーリード先端部11Aを有するインナーリード11と、該インナーリード11と一体となって連結された外部回路と接続するためのアウターリード12、樹脂封止の際の樹脂の流出を防ぐためのダムバー13等を有するもので、42%ニッケル-鉄合金を素材とした、一体ものである。インナーリード先端部11Aの厚さは40μm、インナーリード11の幅は1.2mm、長さ1.5mmである。強度的には後工程に充分耐えるものとなっている。インナーリードピッチは0.12mmと、図6(a)に示す半導体装置に用いられている従来のワイヤボンディングを用いた多ピン（小ピッチ）のリードフレームと比べて、狭いピッチである。本実施例のリードフレームのインナーリード先端部11Aは、断面が図2(c)、図2(d)に示すように、半導体素子搭載面側と半導体素子搭載面を挟む両側の面を凹状に形成している。半導体素子搭載面側が凹状であることによりバンプ部がインナーリード先端部11Aの面内に乗り易く、位置ズレが発生してもバンプと先端部が接続しやすい形状である。インナーリード先端部11Aの3面を凹状にしていることにより、機械的にも強いものとしている。

【0011】本実施例のリードフレームを用いた樹脂封止型の半導体装置の作製には、半導体素子の端子部との接続にワイヤボンディングを行わず、バンプによる接続を行うものであるが、樹脂の封止、ダムバーの切除等の処理は、基本的に通常のリードフレームを用いたワイヤボンディング接続を施した半導体装置と同じ処理で行うことができる。図6(b)は、本実施例リードフレームを用いた樹脂封止型半導体装置の概略構成を示した断面図である。

【0012】本発明のリードフレームの製造方法の実施例を以下、図にそって説明する。図4は本発明の実施例のリードフレームの製造方法を示すための、半導体素子をバンプを介して搭載するインナーリード先端部を含む要部における各工程断面図であり、ここで作製されるリードフレームを示す平面図である図3(a)のC1-C2部の断面部についての製造工程図である。図4中、41はリードフレーム素材、42A、42Bはレジストパターン、43は第一の開口部、44は第二の開口部、45は第一の凹部、46は第二の凹部、47は平坦表面、48はエッチング抵抗膜、49はインナーリード先端部を示す。まず、42%ニッケル-鉄合金からなり、厚みが0.15mmのリードフレーム素材41の両面に、亜クロム酸カリウムを感光剤とした水溶性レジスト1レジストを塗布した後、レジストパターン42を用いて、所定開口部の第一の開口部43、第二の開口部44を形成し、レジスト

ターン42A、42Bを形成した。図4(a)の第一の開口部43は、後のエッチング加工においてリードフレーム素材41をこの開口部からベタ状に腐蝕するためのもので、レジストの第二の開口部44は、リードフレームの半導体素子をバンプを介して搭載するインナーリード先端部の形状を形成するためのものである。第一の開口部43は、少なくともリードフレーム41のインナーリード先端部形成領域を含むが、後工程において、テーピングの工程や、リードフレームを固定するクランプ工程で、ベタ状に腐蝕され部分的に薄くなった部分との段差が邪魔になる場合があるので、エッチングを行う際にはインナーリード先端部形成領域にのみエッチング液の浸入を抑制する必要がある。次いで、温度70℃、濃度48Bxの塩化第二鉄溶液を用いて、スプレー処理、5k g/cm²にて、レジストパターンが形成されたリードフレーム素材41の両面をエッチングし、ベタ状（平坦状）に腐蝕された第一の凹部45の深さがリードフレーム部材の1/3に達した時点でエッチングを止めた。図4(b)。

この段階で、図4(c)に示すインナーリード先端部49部の（平面的な意味での）外形形状が実質的に作られている。上記第1回目のエッチングにおいては、リードフレーム素材41の両面から同時にエッチングを行ったが、必ずしも両面から同時にエッチングする必要はない。少なくとも、インナーリード先端部形状を形成するための、所定形状の開口部をもつレジストパターン42Bが形成された面側から腐蝕液によるエッチング加工を行い、腐蝕されたインナーリード先端部形成領域において、所定量エッチング加工し止めることができれば良い。本実施例のように、第1回目のエッチングにおいて、リードフレーム素材41の両面から同時にエッチングする理由は、両面からエッチングすることにより、後述する第2回目のエッチング時間を短縮するためで、レジストパターン42B側からのみの片面エッチングの場合と比べ、第1回目エッチングと第2回目エッチングのトータル時間が短縮される。次いで、第二の開口部44側の腐蝕された第二の凹部46にエッチング抵抗膜48としての耐エッチング性のあるホットメルト型ワックス（サ・インクテック社製の融ワックス、型番MR-WH-6）を、ダイコータを用いて、塗布し、ベタ状（平坦状）に腐蝕された第二の凹部46に埋め込んだ。レジストパターン42B上も該エッチング抵抗膜48に塗布された状態とした。図4(d)。

エッチング抵抗膜48を、レジストパターン42Bの全面に塗布する必要はないが、第二の凹部46を含む部分にのみ塗布することは好ましい。図4(e)に示すように、第二の凹部46とともに、第二の凹部46の側面にもエッチング抵抗膜48を塗布した。本実施例で使用したエッチング抵抗膜48は、アルカリ、酸型のエッチング液に耐えるが、リードフレームの素材に由来する、

ング時にある程度の柔軟性のあるものが、好ましく、特に、上記ワックスに限定されず、いい硬化型のものが良い。このようにエッチング抵抗層48をインナーリード先端部の形状を形成するためのパターンが形成された面側の腐蝕された第二の凹部46に埋め込むことにより、後工程でのエッチング時に第二の凹部46が腐蝕されて大きくならないようにしているとともに、高精細なエッチング加工に対して機械的な強度補強をしておき、スプレー圧を高く(2.5 kg/cm²)とすることができ、これによりエッチングが深さ方向に進行し易くなる。この後、へく状(平坦状)に腐蝕された第一の凹部45の底面側からリードフレーム材料41をエッチングし、貫通させ、インナーリード先端部49を形成した。(図4(d))

この際、インナーリード先端部のエッチング形成面49Sはインナーリード側にへこんだ凹状になる。また、先の第1回目のエッチング加工にて作製された、エッチング形成面49Sを挟む2面もインナーリード側にへこんだ凹状である。次いで、洗浄、エッチング抵抗層48の除去、レジスト膜(レジストパターン42A、42B)の除去を行い、インナーリード先端部49が微細加工された図4(a)に示すリードフレームを得た。エッチング抵抗層48とレジスト膜(レジストパターン42A、42B)の除去は水酸化ナトリウム水溶液により溶解除去した。

【0013】尚、上記実施例においては、エッチング加工にて、図3(a)に示すように、インナーリード先端部から導体部15を延設し、インナーリード先端部15を繋げた形状にして形成したものを得て、導体部15をプレス等により切断除去して図1(a)に示す形状を得る。図3(a)に示すものを切断し、図1に示す形状にする際には、図3(b)に示すように、通常、補強のためポリイミドテープを使用する。図3(b)の状態では、プレス等により導体部15を切断除去し、図2(a)、図2(b)に示すように半導体素子20をインナーリード先端部11Aにバンパ21を介して搭載した後、図6(a)に示すワイヤボンディング接続のものと同様に、樹脂封止をするが、半導体素子は、テープをつけた状態のままで、図3(b)のように搭載され、そのまま樹脂封止される。

【0014】尚、本方法によるインナーリード先端部49の微細化加工は、第二の凹部46の形状と、最終的に得られるインナーリード先端部の厚さに左右されるもので、例えば、板厚1を50μmまで薄くすると、図4(a)に示す平坦幅Wを100μmとして、インナーリード先端部11Aに1.5mmまで微細加工が可能となる。板厚1を30μm程度まで薄くし、平坦幅Wを70μm程度とすると、インナーリード先端部11Aから1.2mm程度まで微細加工が可能となる。板厚1を20μm程度とすると、インナーリード先端部11Aから0.8mm程度まで微細加工が可能となる。

これは更に狭いピッチまで作製が可能となる。

【0015】

【発明の効果】本発明のリードフレームは、上記のように、半導体素子をバンパを介してインナーリード先端部に搭載する、樹脂封止型半導体装置に用いられるリードフレームにおいて、バンパとバンパを搭載するインナーリード先端部との位置ズレが起きても、電気的接続がし易いものの提供を可能とするものであり、且つ、エッチング加工にてインナーリード先端部の微細加工が可能を構成としている。又、本発明のリードフレームの製造方法は、半導体装置の多端子化に伴う、リードフレームのインナーリード先端部の小ピッチ化・微細化に対応でき、且つ、半導体装置作製のためのアセンブリ工程や実装工程等の後工程にも対応できる、上記本発明のリードフレームの製造を可能とするものである。結局、本発明は、半導体装置用のリードフレームで、半導体装置の多端子化対応でき、且つ、半導体装置作製の後工程にも対応できる、高精細なリードフレームを提供することを可能としている。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例のリードフレーム

【図2】実施例のリードフレームを説明するための図

【図3】エッチング後のリードフレームの形状等を説明するための図

【図4】本発明実施例のリードフレームの製造工程図

【図5】従来のリードフレームのエッチング製造工程を説明するための図

【図6】樹脂封止型半導体装置図

【図7】従来のフリップチップ法を説明するための図

【符号の説明】

10	リードフレーム
11	インナーリード
11A	インナーリード先端部
12	アウトーリード
13	ダムバー
14	フレーム部
15	導体
16	テープ
20、20a	半導体素子
21、21a	バンパ
25、25a	テープ
11	リードフレーム素材
42A、42B	レジストパターン
45	第一の凹部
46	第二の凹部
47	第一の凹部
48	第二の凹部
49	平坦状面
49S	エッチング抵抗層
49T	インナーリード先端部

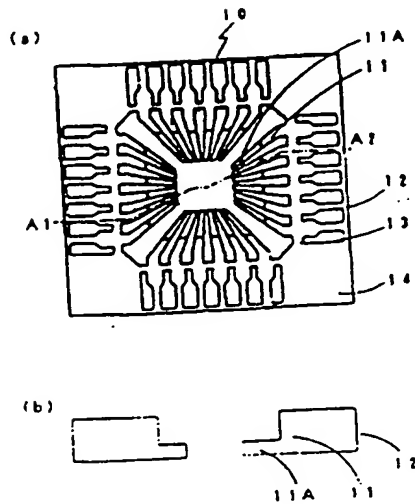
(7)

12

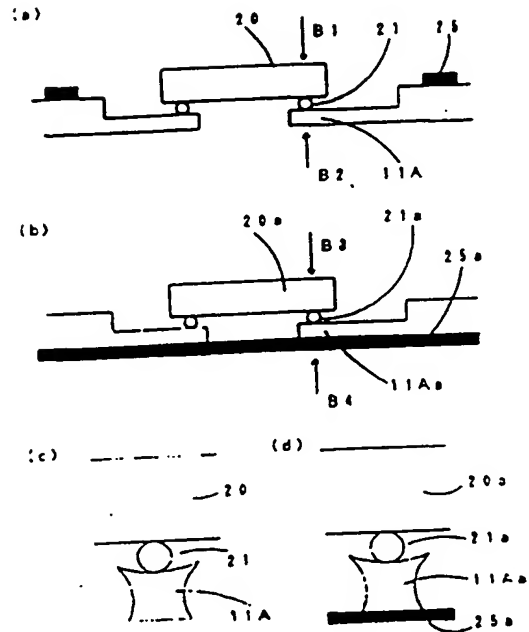
- 51 リードフレーム素材
 52 フォトリソスト
 53 レジストパターン
 54 インナーリード
 60, 60a 樹脂封止型半導体装置
 61, 61a 半導体素子
 62 ダンパッド
 63, 63a インナーリード
 63aA インナーリード先端部
 64, 64a アウターリード

- 65, 65a 出筋
 66 半導体素子電極部
 67 ワイヤ
 67a バンプ
 70 半導体素子
 71 バンプ
 72 配線 (インナーリード)
 72A 電極部 (インナーリード先
 端部)
 10 73 セラミック基板

(11)

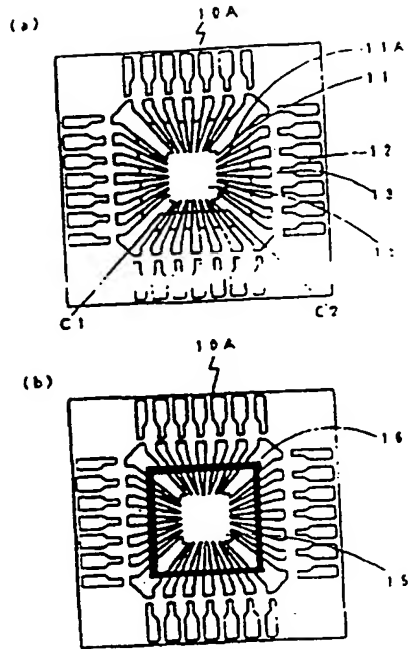


(12)

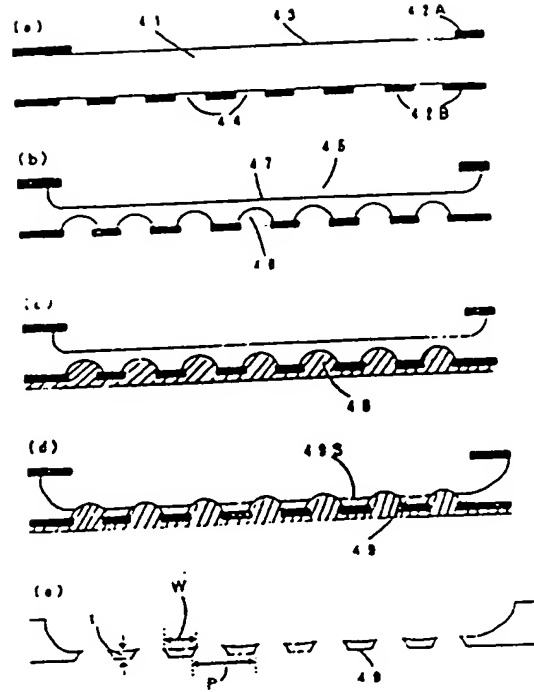


(8)

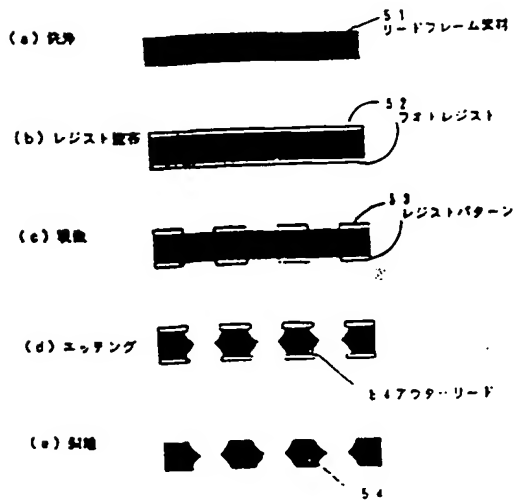
【図5】



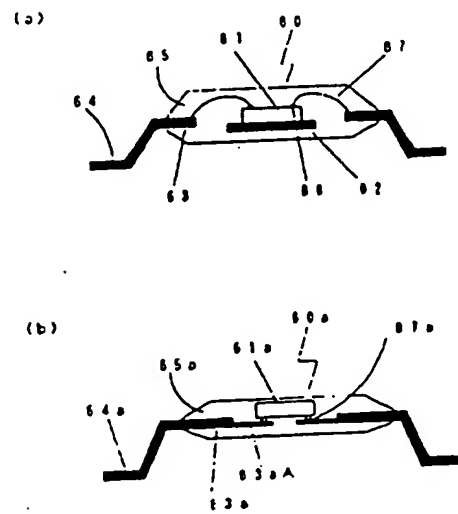
【図4】



【図5】



【図6】



(9)

{147}

